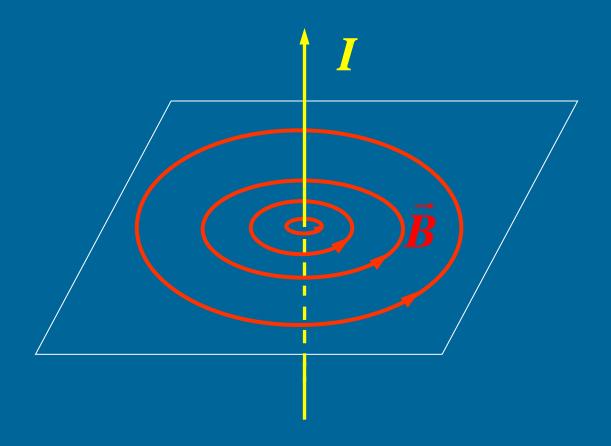
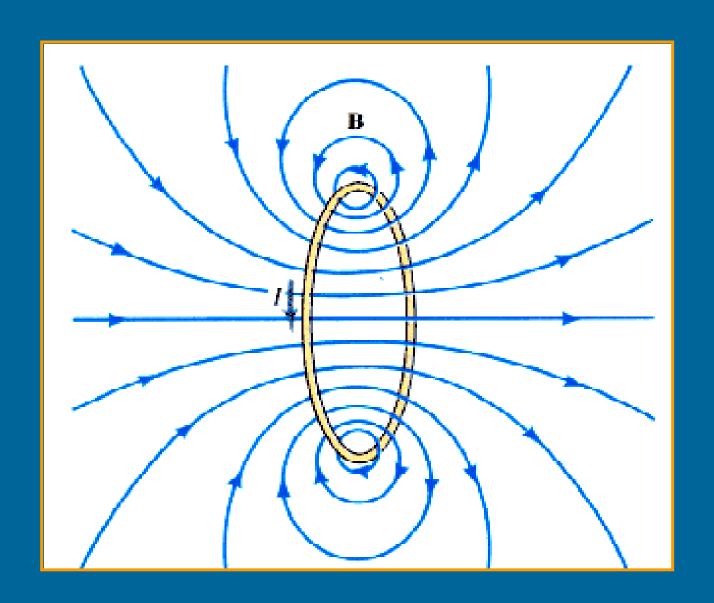
§ 9.3 磁场的高斯定理

静电场:
$$\Phi_e = \oint_{\mathcal{S}} \bar{E} \cdot d\bar{S} = \sum q_i / \varepsilon_0$$
 静电场是有源场

磁 场:
$$\iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = ?$$

- 一. 磁场线
 - 1. 规定
 - (1) 方向: 磁场线切线方向为磁感应强度 \bar{B} 的方向
 - (2) 大小:垂直 \bar{B} 的单位面积上穿过的磁场线条数为磁感应强度 \bar{B} 的大小 $B = \frac{dN}{dS}$
 - 2. 磁场线 (或称为磁感应线) 的特征
 - (1) 磁场线都是环绕电流的无头无尾的闭合曲线 (包括两头伸向无穷远的曲线)



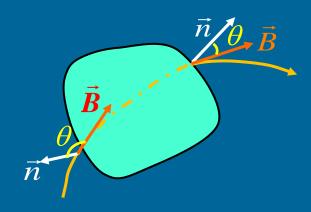


- (2)磁场线的环绕方向与电流方向之间服从右手螺旋定则 (见p57 图11.9)
- (3) 磁场线不相交
- 二. 磁通量 (在磁场中穿过任意曲面 S 的磁场线的条数称该面的磁通量)

面元dS的磁通量 (通过面元的磁场线条数)

$$d\Phi_{m} = dN = BdS_{\perp} = B\cos\theta dS = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$
对于任意曲面
$$\Phi_{m} = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$$
对于闭合曲面
$$\Phi_{m} = \iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

规定: 法线 \bar{n} 向外为正



磁场线穿入 $d\Phi_m < 0$ 磁场线穿出 $d\Phi_m > 0$

三. 磁场的高斯定理

由于磁场线都是闭合的,从一个闭合曲面某处穿 入的磁场线必然从该曲面的另一处穿出,因此通 过任一闭合曲面的总磁通量必然为零, 即:

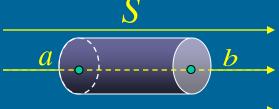
$$\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (磁场高斯定理)$$

磁场高斯定理表明: 电流产生的磁场线 既没有起始点, 也没有终止点, 即磁场 线既没有源头,也没有尾闾 —— 磁场是无源场

例 证明在磁场线 为平行直线的空间中,同一根磁场线 上 各点的磁感应强度值相等。

解
$$\Phi_m = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

 $= -B_a dS + B_b dS = 0$
 $B_a = B_b$



§ 9.4 磁场的安培环路定理

静电场: $\int_{l}^{\bar{E}\cdot d\bar{l}} = 0$ 静电场是保守场

磁 场: $\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = ?$

- 一. 磁场的安培环路定理
 - 以无限长载流直导线为例

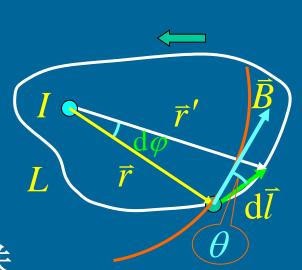
垂直于直导线的平面内取任意闭合回路上

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B \cos \theta dl$$

$$= \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi = \mu_0 I$$
(dl \cos \theta = r d\varphi)

磁场的环流与环路中所包围的电流有关



• 若环路方向反向(不满足右螺旋),情况如何?

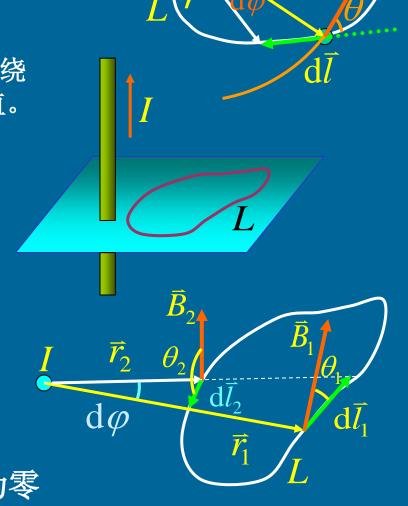
$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L} B \cos(\pi - \theta) dl = \oint_{L} -B \cos \theta dl (1 + \frac{1}{2\pi r}) dr dr = -\mu_{0} I$$

规定:电流为代数量, 电流方向和回路绕行方向构成右旋关系时, 电流取正值。

• 若环路中不包围电流 对一对线元来说

$$\begin{split} & \vec{B}_1 \cdot d\vec{l}_1 + \vec{B}_2 \cdot d\vec{l}_2 \\ &= B_1 dl_1 \cos \theta_1 + B_2 dl_2 \cos \theta_2 \\ &= \frac{\mu_0 I r_1 d\varphi}{2\pi r_1} - \frac{\mu_0 I r_2 d\varphi}{2\pi r_2} = 0 \end{split}$$

环路不包围电流,则磁场环流为零



• 推广到一般情况

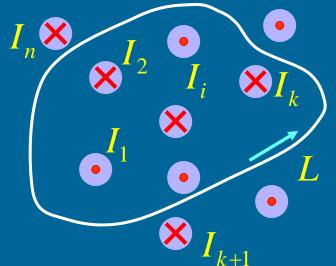
$$\begin{cases} I_1 \sim I_k & \text{在环路 } L \text{ 中} \\ I_{k+1} \sim I_n & \text{在环路 } L \text{ 外} \end{cases}$$

则磁场环流为

$$\begin{split} &\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \sum \vec{B}_i \cdot d\vec{l} \\ &= \sum \oint_L \vec{B}_i \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^k I_i + 0 = \mu_0 \sum_{i=1}^k I_{i \nmid j} \end{split}$$

$$\int_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{i_{||}} \qquad \qquad$$
 安培环路定理

恒定电流的磁场中, 磁感应强度沿一闭合路径 L 的线积分 等于路径 L 包围的电流强度的代数和的 μ_0 倍

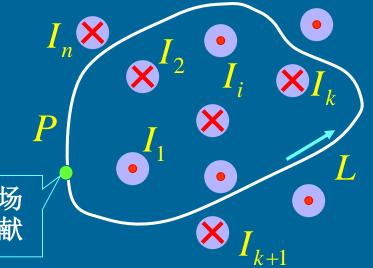


→ 讨论

- (1) 注意电流的正负规定:满足右螺旋关系时 $I_i > 0$ 反之 $I_i < 0$
- (2) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ ≠ 0 磁场是有旋场 —— 电流是磁场涡旋的轴心
- (3) 安培环路定理只适用于闭合的载流导线,对于任意设想的一段载流导线不成立

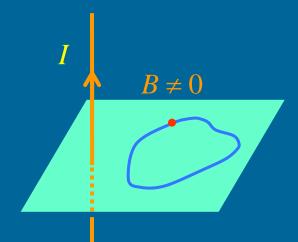
例如 图中载流直导线,设 $\theta_1 = \theta_2 = \pi/4$ I 则 L 的环流为: $\int_L \overline{B} \cdot d\overline{l} = \oint_L \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos(\pi - \theta_2)) dI$ $= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} 2^{\frac{\sqrt{2}}{2}} 2\pi a = \frac{\mu_0 \sqrt{2}I}{2} \neq \mu_0 I$

(4) $\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 积分值与闭合路径的形状无关,只和闭合路径所包围的电流的代数和有关。



环路上各点的磁场 为所有电流的贡献

- (5) $\frac{1}{B}$ 是闭合回路内外电流共同激发的。 $\sum_{I,b} I$ 是闭合回路所包围的电流的代数和。
- (6) 当 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ 时 B = 0 吗? 不一定为零,如 L内不包 围电流, $\sum_{I \neq 0} I = 0$,但 $B \neq 0$ 。



(7) 安培环路定理是由长直导线推导出来的,但结论具有普遍性,可以用它求磁感应强度,但应用它求磁感应强度。 强度是有条件的:

- (I) 要求磁场分布具有一定对称性;
- (II) 能够选择适当的闭合积分路径, 使得积分得以方便地算出。

二. 安培环路定理的应用

例 求无限长圆柱面电流的磁场分布。

解 系统有轴对称性,圆周上各点的B相同 r > R 时过圆柱面外P 点做一圆周作为 积分路径L,逆时针为正

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L} B \cos \theta dl = B \oint_{L} dl$$

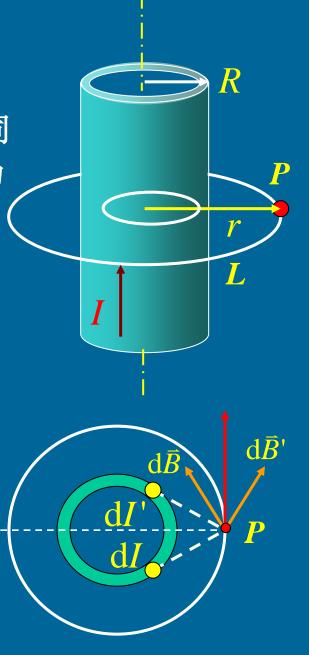
$$= B2\pi r = \mu_{0} I$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_{0} I}{2\pi r}$$

r < R 时在圆柱面内做一圆周,逆正

$$\oint_{L} B \cos \theta dl = B \oint_{L} dl = B 2\pi r = 0$$

$$\Rightarrow B = 0$$

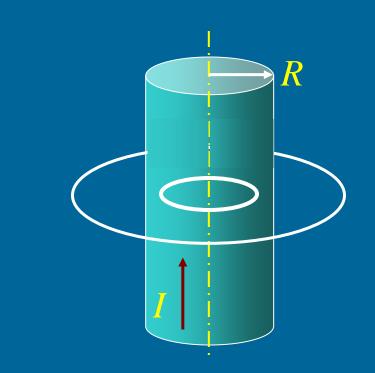


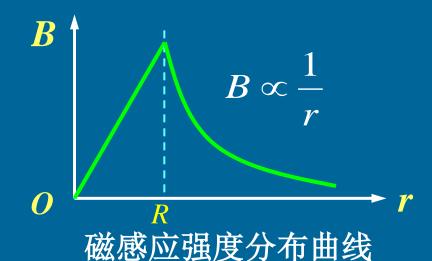
推广: 无限长圆柱体载流 直导线的磁场分布

$$r > R$$
 区域:
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

r < R 区域: $B2\pi r = \mu_0 j\pi r^2$

$$j = \frac{I}{\pi R^2}$$
$$B = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$$

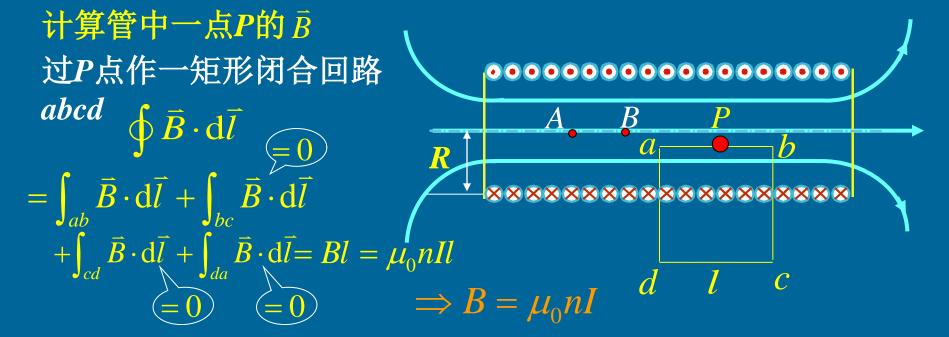




载流长直螺线管内的磁场

可看作无限长直螺线管

缠绕均匀紧密的长直螺线管(L>>R),通有电流 I 由电流分布的对称性知管内磁场线为一系列与轴线平行的直线(如图),由于L>>R,管内任取A,B 点相对于两边的电流位置相同,所以 B 相同,即同一磁场线上各点 B 相同。又磁场线是闭合的,在管内很集中,管外分布在无穷大的区域内,和管内相比 $B_{A} \approx 0$



→总结

1. 磁场的高斯定理

$$\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

2. 磁场的安培环路定理

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \sum I_{i \nmid j}$$